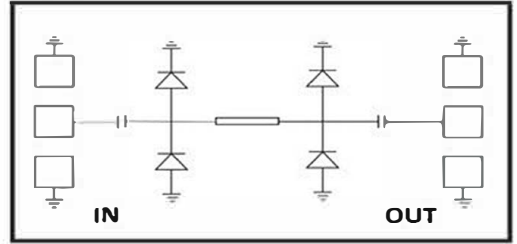


GaAs 限幅器芯片 6-13GHz

主要性能

- ◎ 工作频段：6~13 GHz
- ◎ 插入损耗：0.43 dB
- ◎ 限幅电平：14 dBm
- ◎ 最大输入功率：18W (pulsed.PW=20ms.DC=40%)
- ◎ 芯片尺寸：1.468 x 0.927 x 0.1mm
- ◎ 输入、输出端皆有隔直电容

功能框图



产品简介

该限幅器芯片具有较低的插损和优良的限幅特性，非常适用于微波混合集成电路及TR组件模块等领域。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理，适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。可应用于以下范围：

- ◎ 无线通信设备
- ◎ 军事和航天
- ◎ 测试仪器
- ◎ 雷达和电子对抗

极限参数

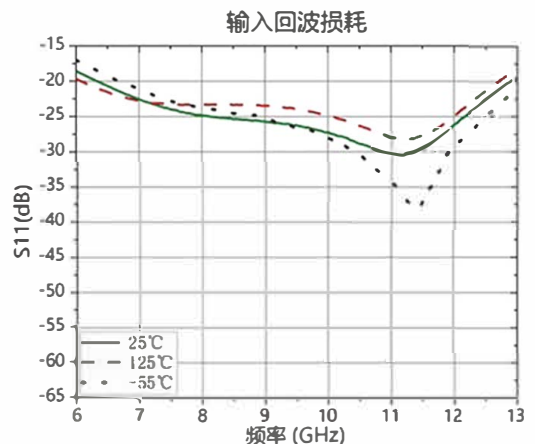
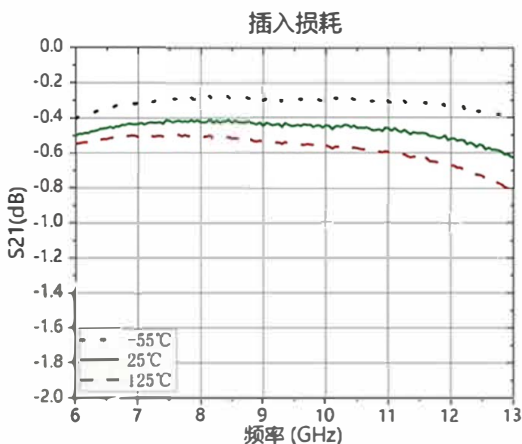
指标	数值	备注
最大输入功率	18W(pulsed.PW=20ms.DC=40%)25°C	CW, +25°C
烧结温度	290°C	-
存储温度	-55~150°C	-
工作温度	-55~125°C	-

注：超过最大值都有可能造成永久性损坏

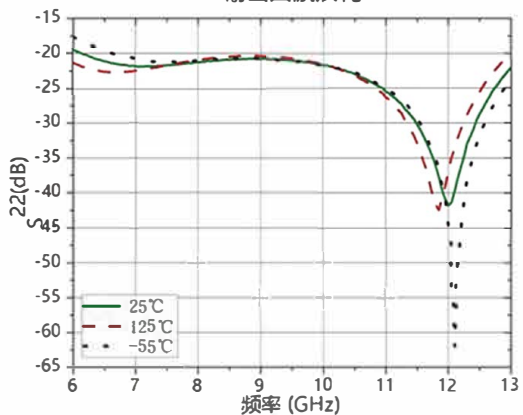
电性能表 (TA=+25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	-	0.43	-	dB
回波损耗	18	25	30	dB
限幅电平	-	14	-	dBm
最大输入功率	-	18	-	W

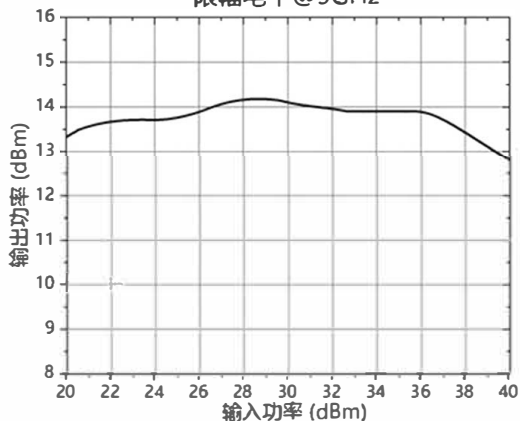
典型测试曲线



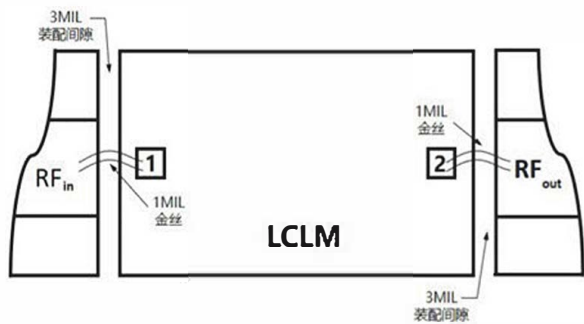
输出回波损耗



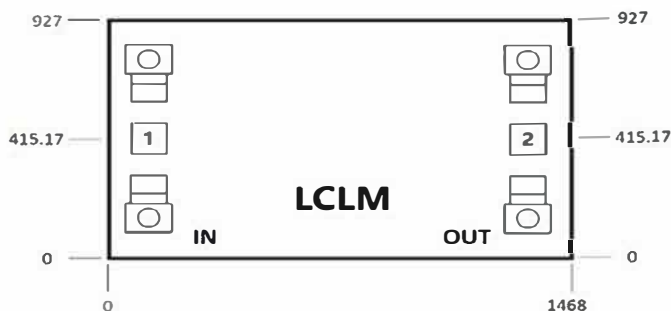
限幅电平@9GHz



装配示意图



芯片尺寸图



说明:

1. 单位: 微米 (μm), 尺寸公差: ±50μm
2. 键合压点镀金, 压点尺寸: 100μm x 100μm
3. 芯片背面镀金
4. 芯片背面接地
5. 不可在通孔上进行键合
6. 压点间隙: 150μm (GSG)

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RF _{in}	RF 输入端, 阻抗 50Ω
2	RF _{out}	RF 输出端, 阻抗 50Ω
-	GND	芯片背面必须接地